

PNP SILICON AMPLIFIER TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/357

Devices

2N3634	2N3635	2N3636	2N3637
2N3634L	2N3635L	2N3636L	2N3637L

Qualified Level

JAN
JANTX
JANTXV
JANS

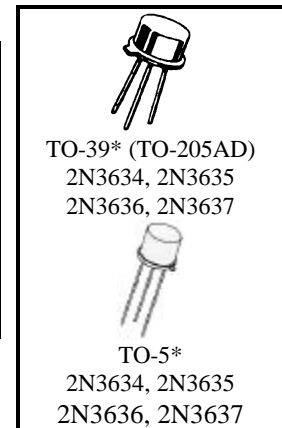
MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N3634* 2N3635*	2N3636* 2N3637*	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	140	175	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	140	175	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0		Vdc
Collector Current	I_C	1.0		Adc
Total Power Dissipation	P_T	@ $T_A = +25^{\circ}\text{C}^{(1)}$	1.0	W
		@ $T_C = +25^{\circ}\text{C}^{(2)}$	5.0	W
Operating & Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	-65 to +200		$^{\circ}\text{C}$

*Electrical characteristics for "L" suffix devices are identical to the "non L" corresponding devices

1) Derate linearly 5.71 mW/ $^{\circ}\text{C}$ for $T_A > +25^{\circ}\text{C}$

2) Derate linearly 28.6 mW/ $^{\circ}\text{C}$ for $T_C > +25^{\circ}\text{C}$



*See appendix A for package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Current $I_C = 10 \text{ mAdc}$	2N3634, 2N3635 2N3636, 2N3637	$V_{(BR)CEO}$	140 175	Vdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 100 \text{ Vdc}$ $V_{CB} = 140 \text{ Vdc}$	2N3634, 2N3635	I_{CBO}	100 10	ηAdc μAdc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 3.0 \text{ Vdc}$ $V_{EB} = 5.0 \text{ Vdc}$		I_{EBO}	50 10	ηAdc μAdc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 100 \text{ Vdc}$		I_{CEO}	10	μAdc

2N3634, L, 2N3635, L, 2N3636, L, 2N3637, L JAN SERIES

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit	
ON CHARACTERISTICS (3)					
Forward-Current Transfer Ratio I _C = 0.1 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 1.0 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 10 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 50 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 150 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 0.1 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 1.0 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 10 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 50 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 150 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc}	2N3634, 2N3636 2N3635, 2N3637	h _{FE} h _{FE}	25 45 50 50 30 55 90 100 100 60	150 300	
Collector-Emitter Saturation Voltage I _C = 10 mA _{dc} , I _B = 1.0 mA _{dc} I _C = 50 mA _{dc} , I _B = 5.0 mA _{dc}	V _{CE(sat)}		0.3 0.6	V _{dc}	
Base-Emitter Saturation Voltage I _C = 10 mA _{dc} , I _B = 1.0 mA _{dc} I _C = 50 mA _{dc} , I _B = 5.0 mA _{dc}	V _{BE(sat)}	0.65	0.8 0.9	V _{dc}	

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Forward Current Transfer Ratio I _C = 30 mA _{dc} , V _{CE} = 30 V _{dc} , f = 100 MHz	2N3634, 2N3636 2N3635, 2N3637	h _{fe}	1.5 2.0	8.0 8.5	
Forward Current Transfer Ratio I _C = 10 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} , f = 1.0 kHz	2N3634, 2N3636 2N3635, 2N3637	h _{fe}	40 80	160 320	
Small-Signal Short-Circuit Input Impedance I _C = 10 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} , f = 1.0 kHz	2N3634, 2N3636 2N3635, 2N3637	h _{je}	100 200	600 1200	Ω Ω
Small-Signal Open-Circuit Output Admittance I _C = 10 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} , f = 1.0 kHz		h _{oe}		200	μs
Output Capacitance V _{CB} = 20 V _{dc} , I _E = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz		C _{obo}		10	pF
Input Capacitance V _{EB} = 1.0 V _{dc} , I _C = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz		C _{ibo}		75	pF
Noise Figure V _{CE} = 10 V _{dc} , I _C = 0.5 mA _{dc} , R _g = 1.0 Ω f = 100 Hz f = 1.0 kHz f = 10 kHz		NF		5.0 3.0 3.0	dB

SAFE OPERATING AREA

DC Tests T _C = 25 ⁰ C, 1 Cycle, t = 1.0 s	
Test 1 V _{CE} = 100 V _{dc} , I _C = 30 mA _{dc} V _{CE} = 130 V _{dc} , I _C = 20 mA _{dc}	2N3634, 2N3635 2N3636, 2N3637
Test 2 V _{CE} = 50 V _{dc} , I _C = 95 mA _{dc}	
Test 3 V _{CE} = 5.0 V _{dc} , I _C = 1.0 A _{dc}	

(3) Pulse Test: Pulse Width = 300μs, Duty Cycle ≤ 2.0%.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331